

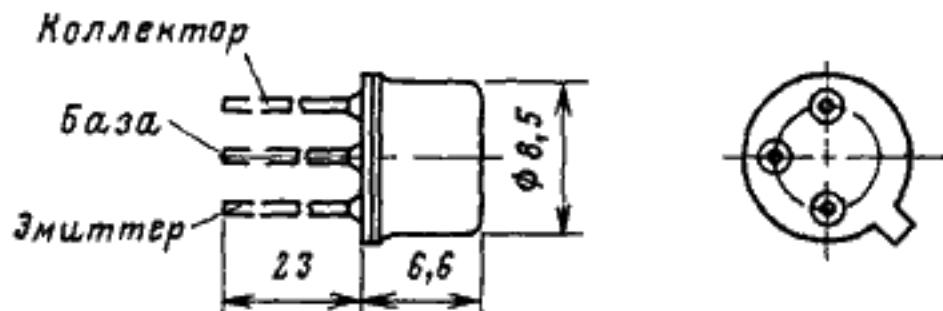
КТ630А, КТ630Б, КТ630В, КТ630Г, КТ630Е

Транзисторы кремниевые планарные *n-p-n* усиительные высокочастотные

Предназначены для усилительных и импульсных схем

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса

Масса транзистора не более 2 г



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{K3} = 10$ В, $I_K = 150$ мА

при $T = 298$ К

КТ630А	40 – 120
КТ630Б	80 – 240
КТ630В, КТ630Г	40 – 120
КТ630Д	80 – 240
КТ630Е	160 – 480

при $T = 398$ К

КТ630А	40 – 240
КТ630Б	80 – 480
при $T = 213$ К		
КТ630А	15 – 120
КТ630Б	30 – 240

Граничное напряжение при $I_3 = 100$ мА, $\tau_u \leq 300$ мкс,

$Q \geq 200$ не менее

КТ630А	90 В
КТ630Б	80 В
КТ630В	100 В
КТ630Г	60 В
КТ630Д, КТ630Е	50 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K =$

= 150 мА, $I_B = 15$ мА не более 0,3 В

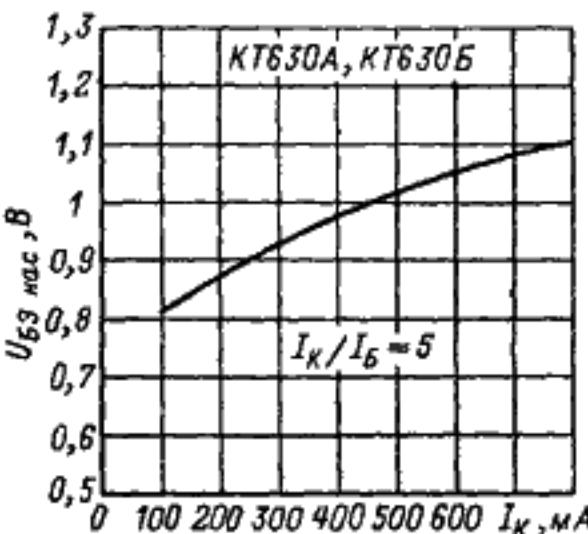
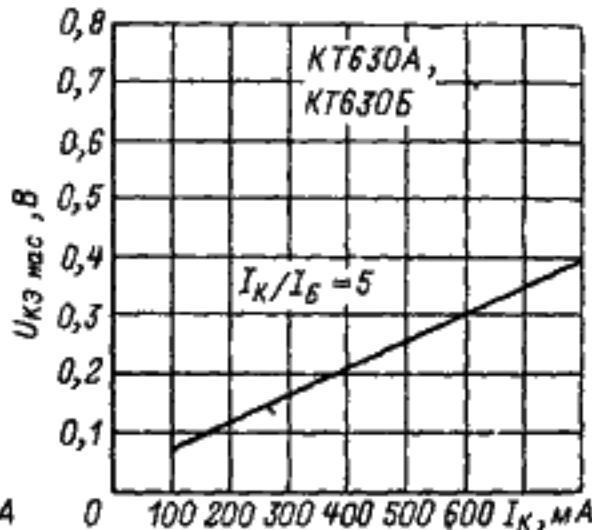
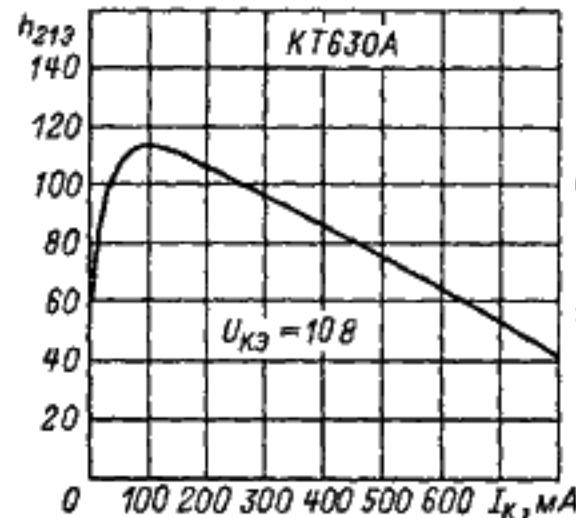
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 150$ мА, $I_B = 15$ мА не более	1,1 В
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_K = 10$ В, $I_K = 60$ мА не менее	50 МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB0} = 10$ В не более	15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB0} = 0,5$ В не более	65 пФ
Входное сопротивление в схеме с общей базой в режиме малого сигнала* при $U_{KB} = 10$ В, $I_E = 5$ мА, $f = 270$ Гц	5–8 Ом
Входное сопротивление в схеме с общим эмит- тером в режиме малого сигнала при $U_{KE} = 10$ В, $I_K = 5$ мА, $f = 270$ Гц	200–1200 Ом
Время включения* при $I_K = 200$ мА, $I_B = 40$ мА, $t_u = 10$ мкс	0,04–0,25 мкс
типовое значение	0,1* мкс
Время выключения* при $I_K = 200$ мА, $I_B = 40$ мА, $t_u = 10$ мкс	0,08–0,5 мкс
типовое значение	0,25* мкс
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $I_K = 100$ мкА $R_{EB} = 3$ кОм не менее:	
КТ630А, КТ630Б	120 В
КТ630В	150 В
КТ630Г	100 В
КТ630Д, КТ630Е	60 В
Постоянное напряжение база-эмиттер при $I_E = 100$ мкА не менее:	
КТ630А, КТ630Б, КТ630В	7 В
КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е	5 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{EB} = 3$ кОм КТ630А, КТ630В при $U_{KE} = 80$ В; КТ630Г, КТ630Д, КТ630Е при $U_{KE} = 40$ В не более	1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{EB0} = 5$ В не более	0,1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{EB} =$ = 3 кОм:	
КТ630А, КТ630Б	120 В
КТ630В	150 В
КТ630Г	100 В
КТ630Д, КТ630Е	60 В
Постоянное напряжение коллектор-база:	
КТ630А, КТ630Б	120 В
КТ630В	150 В
КТ630Г	100 В
КТ630Д, КТ630Е	60 В

Постоянное напряжение эмиттер-база KT630А, KT630Б, KT630В, KT630Г, KT630Д	7 В
Постоянный ток коллектора KT630А, KT630Б, KT630В, KT630Г, KT630Д, KT630Е	1 А
Импульсный ток коллектора KT630А, KT630Б, KT630В, KT630Г, KT630Д, KT630Е	2 А
Постоянный ток базы KT630А, KT630Б, KT630В, KT630Г, KT630Д, KT630Е	0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 233 - 298$ К KT630А, KT630Б, KT630В, KT630Г, KT630Д, KT630Е	0,8 Вт
при $T = 358$ К KT630А, KT630Б, KT630В, KT630Г, KT630Д, KT630Е	0,2 Вт



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.

Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.